



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HC5200M

对应国外型号
2SC5200

■ 主要用途

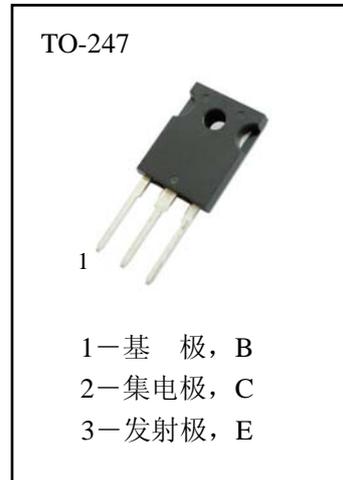
音频功率放大。与 HA1943M 互补。

■ 极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg}	— 贮存温度	-55~150 $^\circ\text{C}$
T_j	— 结温	150 $^\circ\text{C}$
P_C	— 集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150W
V_{CBO}	— 集电极—基极电压	230V
V_{CEO}	— 集电极—发射极电压	230V
V_{EBO}	— 发射极—基极电压	5V
I_C	— 集电极电流 (DC)	15A
I_C	— 集电极电流 (脉冲)	30A
I_B	— 基极电流	1.5A

■ 电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

■ 外形图及引脚排列



参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	230			V	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	230			V	$I_C=50\text{mA}, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			5	μA	$V_{CB}=230\text{V}, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			5	μA	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	55		160		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$
$H_{FE}(2)$		35				$V_{CE}=5\text{V}, I_C=7\text{A}$
V_{BE}	基极—发射极电压			1.5	V	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=7\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			3	V	$I_C=8\text{A}, I_B=0.8\text{A}$
f_T	特征频率		30		MHz	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$
C_{ob}	共基极输出电容		200		pF	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$

■ HFE (1) 分档及其标志

R

0

55—110

80—160



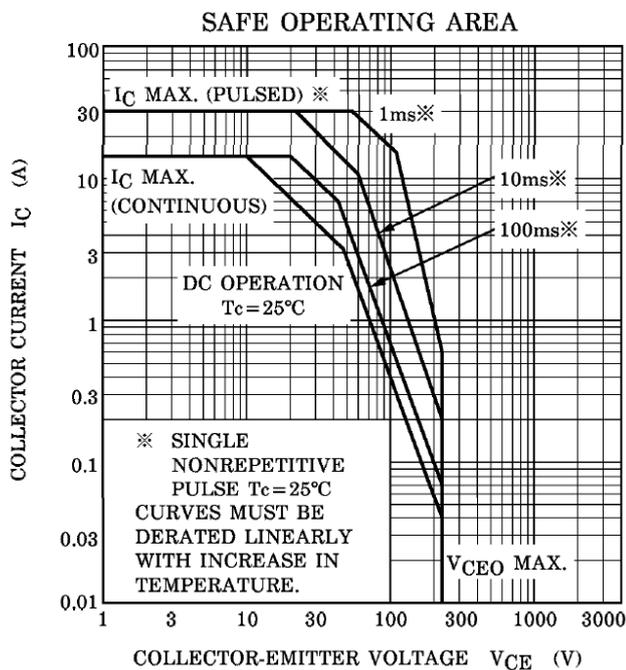
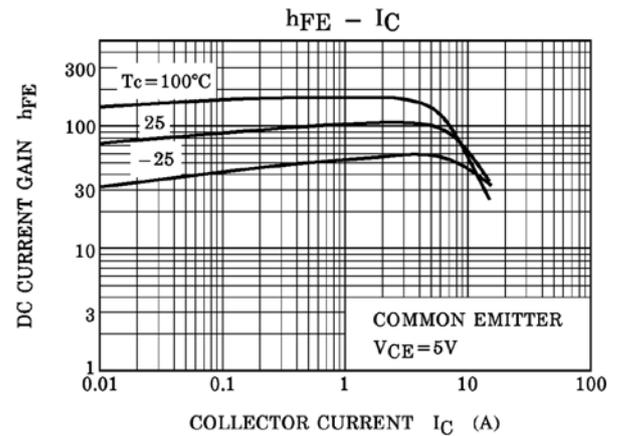
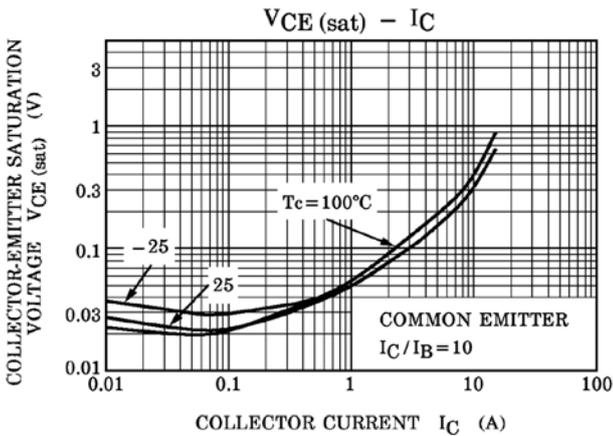
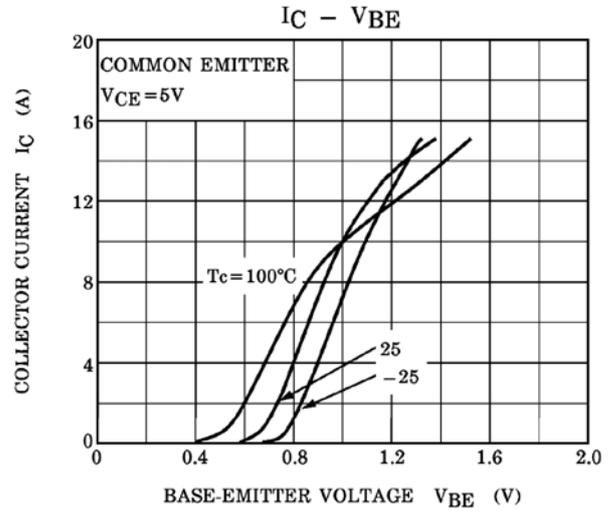
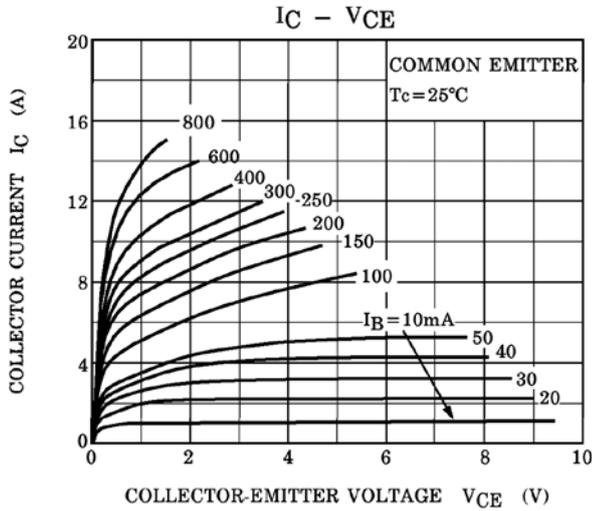
汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HC5200M

对应国外型号
2SC5200

■ 典型特性曲线





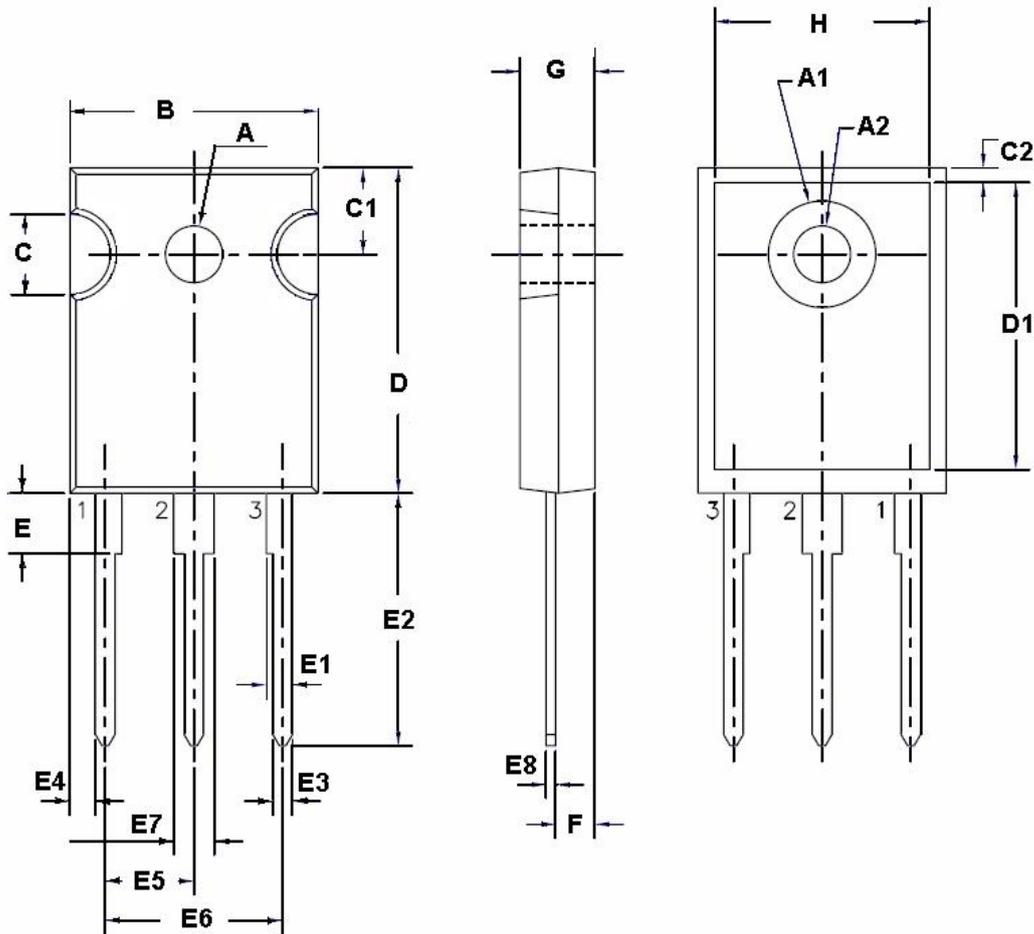
汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HC5200M

对应国外型号
2SC5200

■ 外形尺寸图



(单位: mm)

尺寸 符号	Min	Nom	Max	尺寸 符号	Min	Nom	Max	尺寸 符号	Min	Nom	Max
A ϕ	3.51		3.65	D	20.32		20.82	E5	(5.56)		
A1 ϕ	6.61		6.85	D1	13.08			E6	(11.12)		
A2 ϕ	3.51		3.65	E	3.69		3.93	E7	2.42		2.66
B	15.37		15.87	E1	1.53		1.77	E8	0.51		0.71
C	4.96		5.2	E2	15.75		16.25	F	2.29		2.66
C1	5.34		5.58	E3	1.17		1.35	G	4.58		4.82
C2	0.51		1.35	E4	(1.6)			H	12.81		

注: ()内的数值为参考数值